

# セッション一覧表

平成 22 年 11 月 27 日（土）～28 日（日）九州大学伊都キャンパス

|                                   |   |                                |                              |                                      |                        |                         |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 11 月 27 日（土）                      | A(313)会場<br>(3F, 130 名)   | B(314)会場<br>(3F, 50 名)         | C(327)会場<br>(3F, 52 名)       | D(326)会場<br>(3F, 52 名)               | E(325)会場<br>(3F, 63 名) | F(323)会場<br>(3F, 63 名)  |
| 9:24-10:42<br>AM 前半 I<br>(6 件)    | 半導体 B<br>吉武 剛<br>九大総理工  | 計測・制御<br>応用物性<br>川崎仁晴<br>佐世保高専 | スピン・マグ<br>ネ<br>佐道 泰造<br>九大シ情 | 光、光エレ、量<br>子エレ<br>平川 靖之<br>久留米高専     | プラズマ<br>林 信哉<br>佐大理工   | 薄膜・表面<br>安田 敬<br>九工大情   |
| 10:42-10:50                       | 休憩  |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 10:50-12:08<br>AM 後半 II<br>(6 件)  | 半導体 B<br>高倉 健一郎<br>熊本高専   | 結晶工学<br>鈴木 芳文<br>九工大工          | 半導体 A<br>佐道 泰造<br>九大シ情       | 光、光エレ、量<br>子エレ<br>高橋 昭彦<br>九大医       | プラズマ<br>福澤 剛<br>北九州高専  | 薄膜・表面<br>古川 昌司<br>九工大情  |
| 12:08-13:00                       | 昼 休 み   |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 13:00-13:20                       | 総会および「応用物理学会九州支部貢献賞」贈呈式（A 会場）   |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 13:20-13:30                       | 休憩  |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 13:30-14:15                       | 特別共通セミナー I「化合物半導体による高機能光・電子デバイスの最前線」（A 会場）（1 件）[Sc-1]                 |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 14:15-14:35                       | 協賛企業講演（A 会場）の後、休憩   |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 14:35-16:06<br>PM 前半 III<br>(7 件) | 特別共通セミナー II（A 会場）<br>「化合物半導体による高機能光・電子デバイスの<br>最前線」（3 件）[Sc-2 ～ Sc-4] |                                |                              | 超伝導<br>木須 隆暢<br>九大シ情                 | プラズマ<br>内田 儀一郎<br>九大シ情 | 薄膜・表面<br>安田 敬<br>九工大情   |
| 16:06 -16:15                      | 休憩  |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 16:15-17:59<br>PM 後半 IV<br>(8 件)  | 半導体 B<br>福山 敦彦<br>宮崎大工  | 結晶工学<br>堀江 雄二<br>鹿大理工          | 応用物理一般<br>栗焼久夫<br>九大シ情       | 超伝導<br>小田部 荘司<br>九工大情<br>(7 件)→17:46 | プラズマ<br>松田 良信<br>長大生科  | 有機・バイオ<br>古川 昌司<br>九工大情 |
| 17:59-19:00                       | 移動  |                                |                              |                                      |                        |                         |
| 19:00-20:30                       | 懇 親 会（天神ガーデンパレス）  |                                |                              |                                      |                        |                         |

|                                  |                                       |   |  |                                       |                        |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|---|--|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| 11 月 28 日（日）                     | A 会場                                  | B 会場                                    | C 会場   | D 会場                                  | E 会場                   | F 会場                                  |
| 9:24-10:42<br>AM 前半 V<br>(6 件)   | 半導体 B<br>西岡 賢祐<br>宮崎大工                | ビーム・非晶質<br>鈴木 芳文<br>九工大工<br>(5 件)→10:29 | 光、光エレ、<br>量子エレ<br>中村 大輔<br>九大シ情                | 有機・バイオ<br>林 健司<br>九大シ情                | 半導体 A<br>浅野 種正<br>九大シ情 | 薄膜・表面<br>福山 敦彦<br>宮崎大工                |
| 10:42-10:50                      | 休憩                                    |   |  |                                       |                        |                                       |
| 10:50-12:08<br>AM 後半 VI<br>(6 件) | 半導体 B<br>佐竹 昭泰<br>九工大工<br>(7 件)→12:21 | 応用物理一般<br>原 一広<br>九大工                   | 光、光エレ、<br>量子エレ<br>内海 通弘<br>有明高専<br>(5 件)→11:55 | 有機・バイオ<br>岡部 弘高<br>九大工<br>(5 件)→11:55 | 半導体 A<br>中島 寛<br>九大総理工 | 薄膜・表面<br>堀江 雄二<br>鹿大理工<br>(4 件)→11:42 |

各セッションの見方：分科名、座長、座長の所属、（ ）内は講演件数

講演番号について：例えば、27Dp-10 は 27 日 D 会場午後の 10 番目の講演という意味

△印のついた講演は発表奨励賞申請の講演